

Exagan bestellt AIX G5+ C für den Produktionsanlauf von GaN-auf-Si-Leistungsschaltern

AIXTRON und Exagan kooperieren bei der Beschleunigung der GaN-auf-Si-Produktionstechnologie für HEMTs auf 200 mm-Siliziumsubstraten

Herzogenrath, Grenoble, 29. Februar 2016 – AIXTRON SE (FSE: AIXA; NASDAQ: AIXG), ein führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, hat eine AIX G5+ C-Anlage an das französische Start-Up Exagan geliefert. Das Unternehmen ist eine Ausgründung von Soitec, einem weltweit führenden Hersteller von innovativen Halbleitermaterialien, sowie von CEA-Leti, einem führenden europäischen Forschungszentrum mit Schwerpunkten in der Mikro- und Nanotechnologie. Exagan stellt Hochleistungswerkstoffe und hocheffiziente Leistungsschalter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) her, die die Leistungsfähigkeit und Effizienz von elektronischen Umrichtern deutlich erhöhen. Die Depositionsanlage von AIXTRON wird das Unternehmen für die Serienfertigung von GaN-auf-Silizium-Materialien für Leistungsschalter einsetzen.

Bei der AIX G5+ C-Planetenanlage handelt es sich um eine fortschrittliche Produktionsplattform in einer 5x200mm-Konfiguration mit Einzelwafer-Rotation, die eine Beladung im Cassette-to-Cassette-Verfahren erlaubt und mit dem In-situ-Reinigungssystem von AIXTRON ausgerüstet ist.

Exagan hat die AIX G5+ C gemeinsam mit seinem F&E-Partner CEA-Leti ausgewählt, nachdem die Anlage größtmögliche Homogenitätskontrolle und hohen Durchsatz unter Nutzung der eigenen G-Stack™ Prozesstechnologie unter Beweis gestellt hatte. Diese Stack-Technologie wird genutzt, um einzigartige GaN-basierte Materialien für die Produktion von Exagans effizienten G-FET™ Hochleistungstransistoren bereitzustellen. Zusammen mit den Fertigungsmöglichkeiten und der Expertise von Soitec sowie den branchenführenden 200 mm Produktions- und Charakterisierungsanlagen von CEA-Leti, ergänzt die AIX G5+ C Exagans Lieferkette während das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Grenoble aufstockt.

Die Installation der Anlage ist in der strategischen Partnerschaft von Exagan und CEA-Leti ein großer Schritt zur Beschleunigung der GaN-auf-Silizium-Pläne von Exagan. Unterstützt wird die Partnerschaft durch das F&E-Projekt „G-drive+“, das von Bpifrance durch Investissements d’Avenir finanziert wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

Fabrice Letertre, COO und Mitbegründer von Exagan, stellt fest: „AIXTRON und CEA-Leti verfügen über eine lange und erfolgreiche F&E-Partnerschaft in der Weiterentwicklung der GaN-auf-Silizium-Technologie. Die Kooperation zwischen Exagan und AIXTRON wird dafür sorgen, dass wir durch den Einsatz des Epitaxie-Verfahrens sowohl unsere Zeitpläne einhalten als auch alle unsere Meilensteine bezüglich der Kosten erreichen. Mittels des effizienten Herstellungsprozesses für GaN-auf-Silizium auf 200 mm-Siliziumsubstraten verbinden wir die GaN-Technologie mit den Produktionsstandards der Siliziumindustrie. Dies macht unsere G-FET-Produkte zu den kosteneffizientesten Wide-Bandgap-Lösungen für die Märkte Solar-, IT-Elektronik-, Verbindungs- und Automotivetechnologie.“

„Unsere AIX G5+ C ist bislang die einzige Anlage, die vollautomatische GaN-auf-Silizium MOCVD-Prozesse wie in der Siliziumindustrie ermöglicht. Die Anlage erreicht die höchste On-Wafer-Uniformity mit einer Multi-Wafer-Konfiguration für maximalen Durchsatz und Ausbeute. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Team von Exagan bei der Serienproduktion von 200 mm GaN-auf-Silizium-Materialien für effiziente Anwendungen in der Leistungselektronik zusammenzuarbeiten“, erklärt Dr. Frank Wischmeyer, Vice President Power Electronics der AIXTRON SE.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], Atomic Level SolutionS[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[®], TriJet[®]

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6; NASDAQ: AIXG, ISIN US0096061041) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Über Exagan

Exagan wurde 2014 mit Unterstützung von CEA-Leti und Soitec gegründet, um den Übergang der Leistungselektronik-Industrie von einer Silizium-basierten Technologie hin zu kleineren, effizienteren auf der GaN-auf-Si-Technologie basierenden Umrichtern zu beschleunigen. Seine GaN-Leistungsschalter sind auf die vollständige Kompatibilität mit 200mm Standard-Silizium Foundries zur Lieferung von hochleistungsfähigen, zuverlässigen Produkten mittels einer stabilen Lieferkette ausgelegt. Die G-FET-Plattformen des Unternehmens bieten sehr hohe Schaltleistungen mit extrem niedrigen Leitungsverlusten, sie ermöglichen beispiellose Leistungsintegration und Effizienzlevel bei elektronischen Umrichtern für die Solar-, Automobil- und IT-Industrie. Exagan hat seinen Hauptsitz im französischen Grenoble und verfügt über eine weitere Niederlassung in Toulouse.

Weitere Informationen sind unter www.exagan.com verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

Über Leti

Als eines von drei Instituten für Spitzenforschung innerhalb der CEA Technologieforschungsabteilung, bildet Leti die Brücke zwischen der Grundlagenforschung und der Produktion von Mikro- und Nanotechnologien, die das Leben von Menschen rund um die Welt verbessern. Leti fühlt sich verpflichtet, Innovationen voranzutreiben und diese in die Industrie zu übertragen. Gestützt auf sein Portfolio von 2.800 Patenten arbeitet Leti partnerschaftlich sowohl mit großen Industrieunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen als auch Start-ups zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition zu finden. Leti hat bislang insgesamt 54 Start-ups ins Leben gerufen. Sein 8.500m² großer, moderner Reinraum erlaubt die Bearbeitung von 200mm und 300mm-Wafern für Mikro- und Nanolösungen, deren Anwendung vom Weltraum bis hin zu intelligenten Geräten reicht. Mit insgesamt 1.800 Angestellten hat Leti seinen Hauptsitz in Grenoble, France, und verfügt darüber hinaus über Büros im Silicon Valley, Kalifornien, USA, sowie in Tokyo.

Weitere Information über Leti sind unter www.leti.fr verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com